

HSPD4040 40G 高速铟镓砷(InGaAs)光电探测器

产品特点

- ◆ 帯宽范围宽
- ◆ 集成偏置器(Bias-T)
- ◆ 直流耦合(DC Coupled)
- ◆ 密封外壳设计,配备 2.92 型连接器

适用领域

- ◆ 高速光纤通信
- ◆ 雷达信息处理
- ◆ 电子战
- ◆ 高速信号测试与测量
- ◆ 微波光子学



产品介绍

HSPD4040 型高速探测器模块适用于数字与模拟两种应用场景,模块内置一款铟镓砷 PIN 光电二极管(InGaAs PIN Photodiode),其响应波长范围为 1250-1650nm,并配备必要的匹配电子元件。

HSPD4040 模块的最大带宽可达 40GHz,工作电压为 +5V,兼容标准单模 9/125 μ m 光纤输入,射频输出端口采用 2.92mm 连接器,阻抗匹配为 50 欧姆。该模块采用密封外壳设计,重量不足 20 克,且符合《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》 2.0 版(ROHS 2.0)标准。

产品选型

典型值与绝对最大额定值								
参数	符号	典型值	额定值	单位				
储存温度范围	TSTG	-45 \sim +85	-55 \sim +85	${\mathbb C}$				
工作壳温范围	тс	25	-40 ∼ +85	$^{\circ}$				
偏置电压	VR	5	5 ~ 6	V				
光输入功率	Pin	+3	+10	mW				
烧毁光功率	РВ	-	+15	mW				
引线焊接温度	Тр	280 (10s)	330 (10s)	$^{\circ}$				



光电器性能参数						
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
响应光谱	λ	1000		1650	nm	
小信号带宽(-3dB)	-3dB	35	40		GHz	-
最大光输入功率	Pm			13	mW	参考备注 2,3
响应度	R	0.75	0.85		A/W	参考备注1
幅度平坦度	Α		±2		dB	
光电二极管偏置电压	Vpd		5	6	V	参考备注3
输出电压驻波比	VSWR		2.5	3	1	
饱和射频输出功率	Pout		-10		dBm	
暗电流	Id		1	40	nA	
输出阻抗	RL		50		Ω	

备注:

- 1. 测试条件为波长 λ=1310nm、1550nm;
- 2. 测试条件为温度 25°C、正常偏置;
- 3. 若器件工作参数超出绝对最大额定值,可能会影响器件可靠性,甚至导致永久性损坏。

典型响应曲线

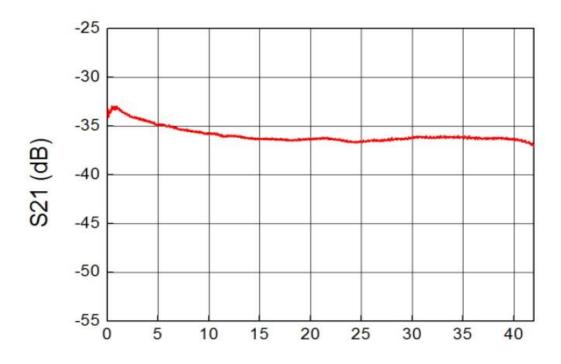
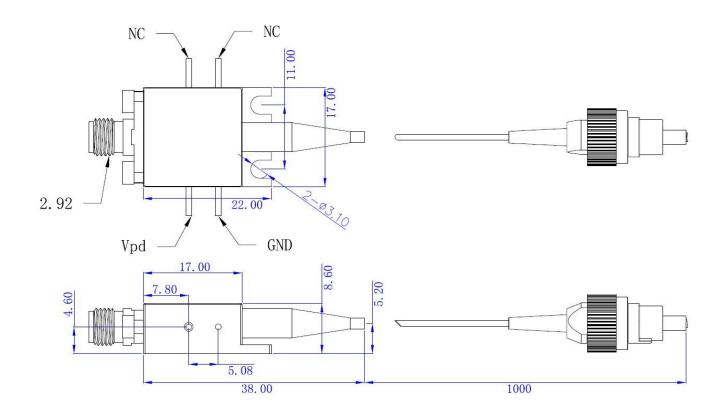


图 1: 40G 光电探测器频率响应曲线



尺寸与引脚(单位: mm)



订货信息

产品型号	备注
HSPD4040	40GHz 光电探测器接收器,配备单模 FC/APC 光纤连接器

注意事项

为避免光纤损坏,光纤弯曲半径不得小于 20mm;

将光纤连接至光电路前,务必确保光纤耦合端面清洁;

器件在储存、运输及使用过程中,需采取适当的静电放电(ESD)防护措施。